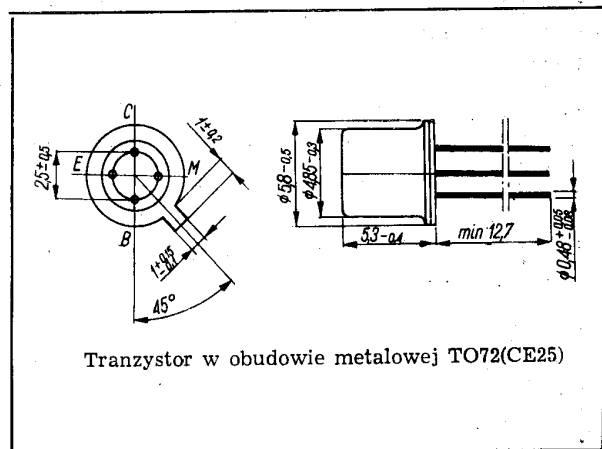


Tranzystory krzemowe epiplanarne małej mocy wielkiej częstotliwości.

Tranzystor BF214 jest przeznaczony do stosowania we wzmacniaczach pośredniej częstotliwości odbiorników radiowych AM oraz AM-FM i pośredniej częstotliwości fonii odbiorników telewizyjnych.

Tranzystor BF215 jest przeznaczony do stosowania we wstępnych stopniach głowic odbiorników radiowych FM.



DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Napięcie kolektor-baza	U_{CB0}	30	V
Napięcie kolektor-emiter	U_{CE0}	30	V
Napięcie emiter-baza	U_{EB0}	4	V
Prąd kolektora	I_C	30	mA
Temperatura złącza	t_j	448 (175)	K (°C)
Zakres temperatury składowania	t_{stg}	248...358 (-25...+85)	K (°C)
Moc strat kolektora przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)	P_C	165	mW

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna złącze-otoczenie	$R_{th(j-a)}$	900	K/W
złącze-obudowa	$R_{th(j-c)}$	500	K/W

TRANZYSTOR BF214

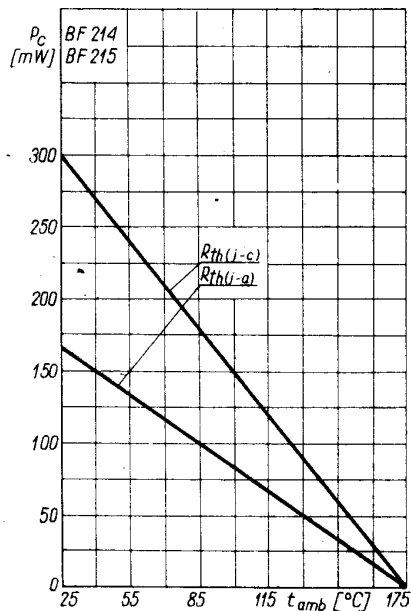
Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)				
Współczynnik wzmocnienia prądowego przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA	h_{21E}	min.	90	maks. 330
Prąd zerowy kolektora przy $U_{CB} = 10$ V	I_{CB0}		100	nA
Napięcie przebicia kolektor-baza przy $I_C = 10 \mu A$, $I_E = 0$	$U_{(BR)CB0}$	30	—	V
Napięcie przebicia kolektor-emiter przy $I_C = 2$ mA, $I_B = 0$	$U_{(BR)CE0}$	30	—	V
Napięcie przebicia emiter-baza przy $I_E = 10 \mu A$, $I_C = 0$	$U_{(BR)EB0}$	4	—	V

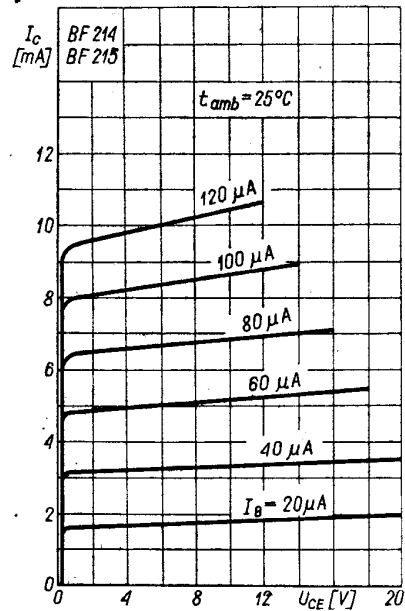
Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)				
Częstotliwość graniczna przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 100$ MHz	f_T	250	—	MHz
Stała czasowa sprzężenia zwrotnego przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 50$ MHz	$\tau_{bb} C_c$	15	22	ps
Współczynnik szumów przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 0.2$ MHz, $R_g = 300 \Omega$	F	1,2	—	dB
przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 1$ MHz, $R_g = 50 \Omega$	F	3,5	—	dB
przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 1$ MHz, $R_g = 300 \Omega$	F	1,2	—	dB

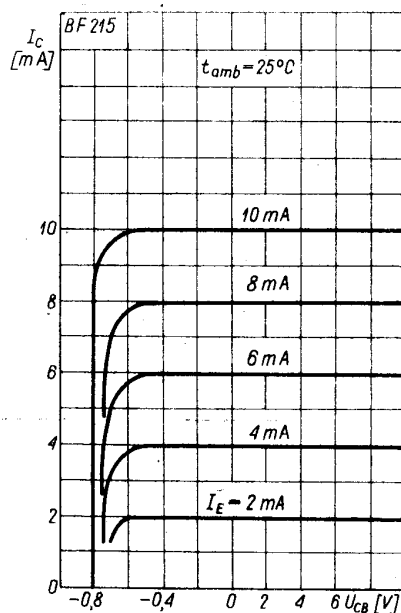
SWW 1156-213



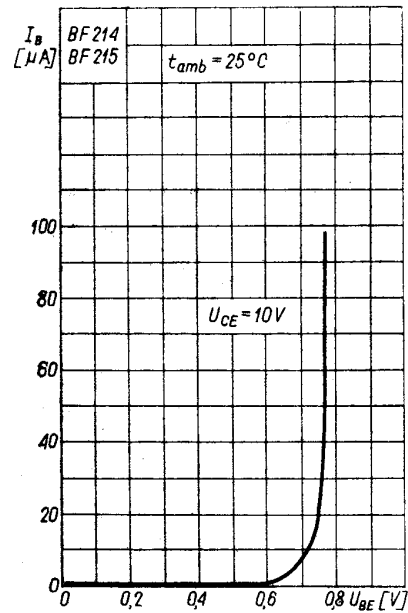
Zależność temperaturowa mocy strat $P_C = f(t_{amb})$



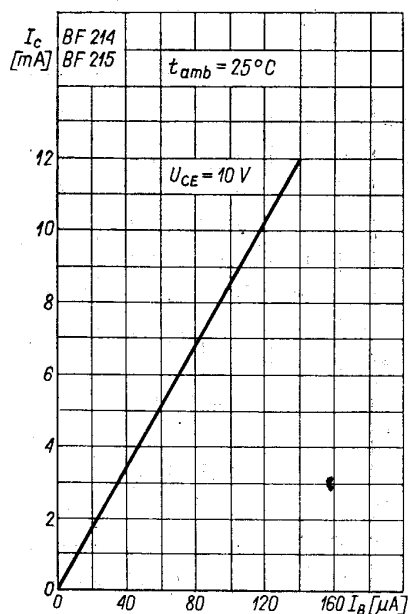
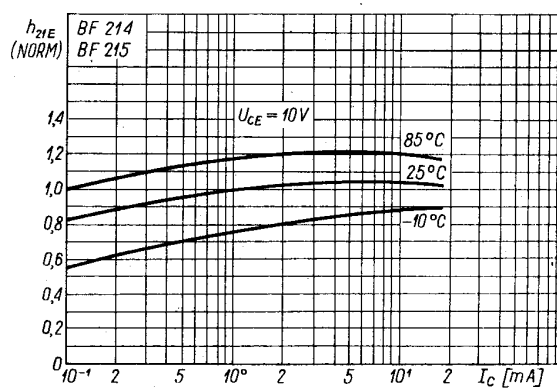
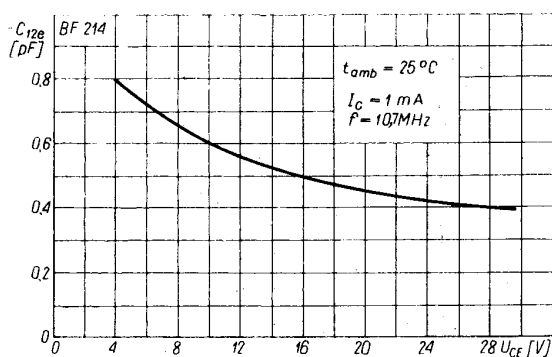
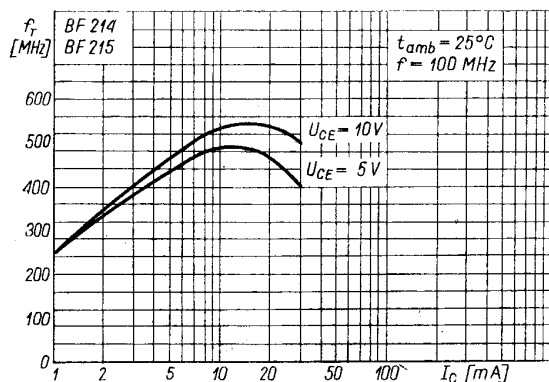
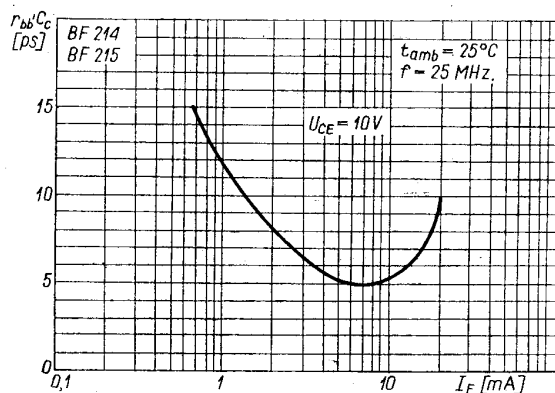
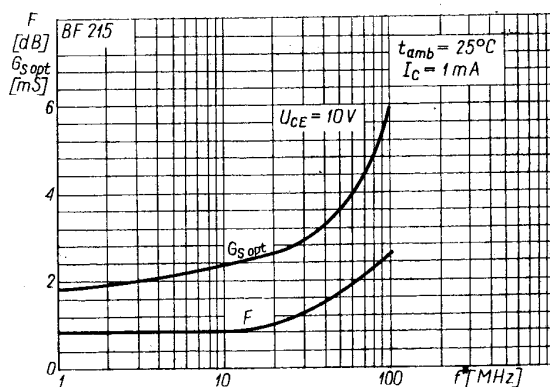
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametr

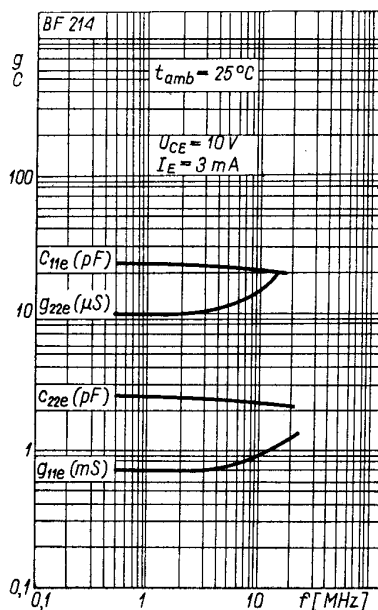
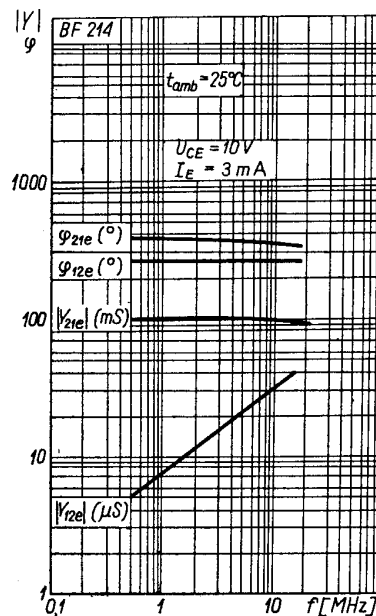
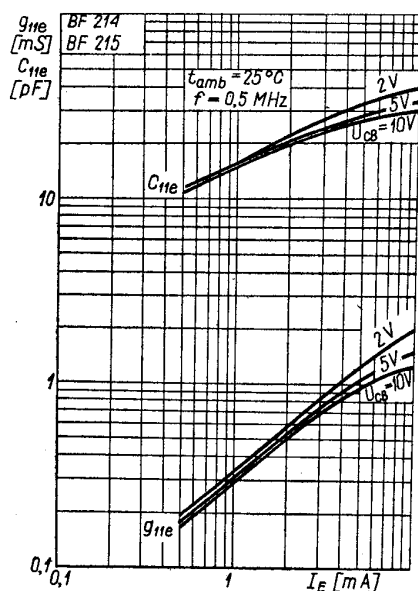
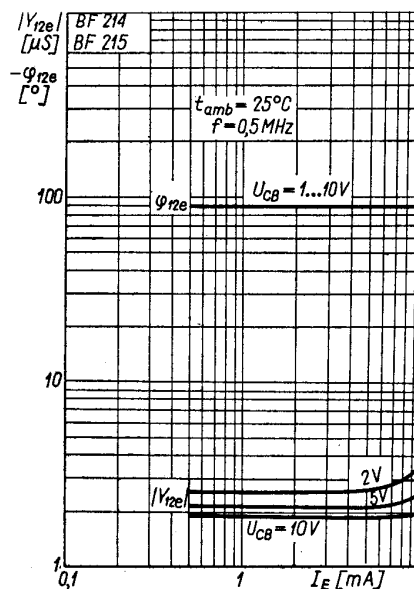


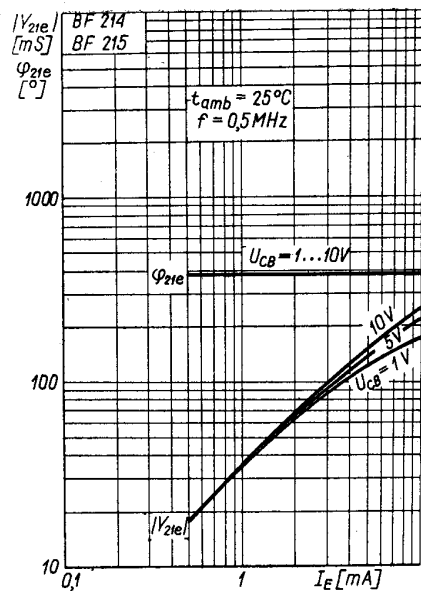
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CB})$; I_E — parametr



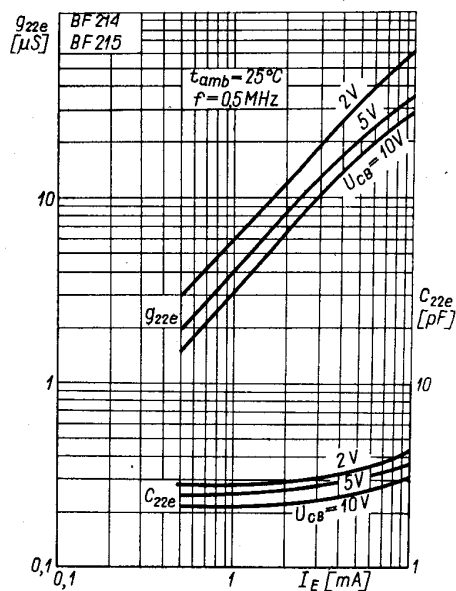
Charakterystyka wejściowa $I_B = f(U_{BE})$

Charakterystyka przejściowa $I_C = f(I_B)$ Zależność statycznego współczynnika wzmocnienia prądowego znormalizowanego od prądu kolektora $h_{21E}(N) = f(I_C)$ Zależność pojemności sprzężenia zwrotnego od napięcia $-C_{12e} = f(U_{CE})$ Zależność częstotliwości granicznej od prądu kolektora $f_T = f(I_C)$ Zależność stałej czasowej sprzężenia zwrotnego od prądu emitera $r_{bb'}C_C = f(I_E)$ Zależność współczynnika szumów i optymalnej konduktancji źródła od częstotliwości F i $G_{sopt} = f(f)$

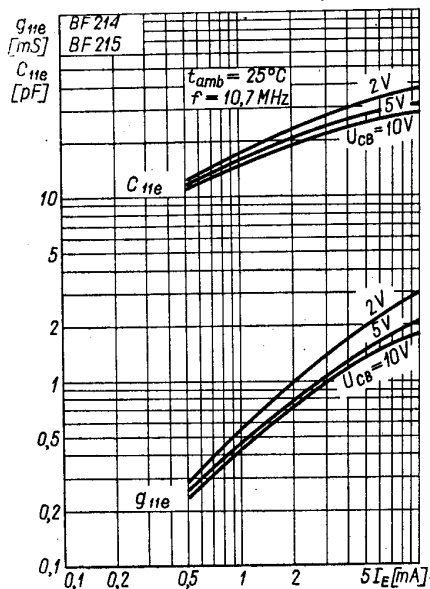
Zależność parametrów Y od częstotliwości $Y = f(f)$ Zależność parametrów Y od częstotliwości $Y = f(f)$ Zależność admitancji wejściowej od prądu emitera g_{11e} ; $C_{11e} = f(I_E)$ Zależność admitancji przenoszenia wstecz od prądu emitera $|Y_{12e}|$; $\varphi_{12e} = f(I_E)$



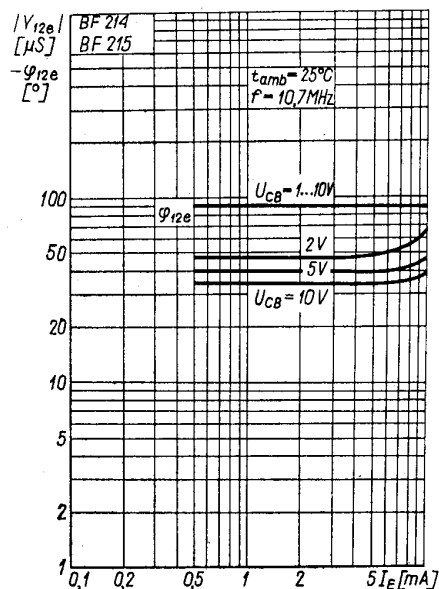
Zależność admitancji przenoszenia w przód od prądu emitera $|Y_{21e}|$; $\varphi_{21e} = f(I_E)$



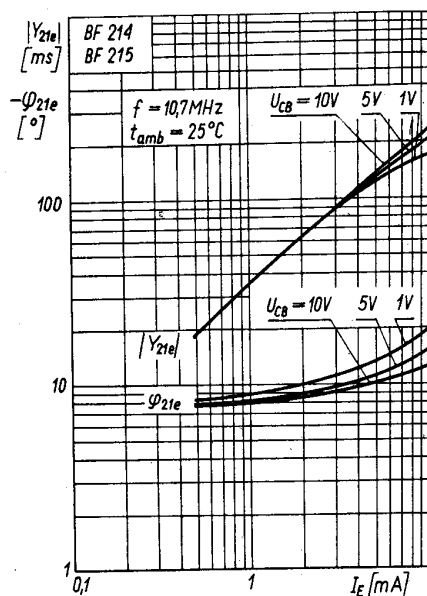
Zależność admitancji wyjściowej od prądu emitera g_{22e} ; $C_{22e} = f(I_E)$



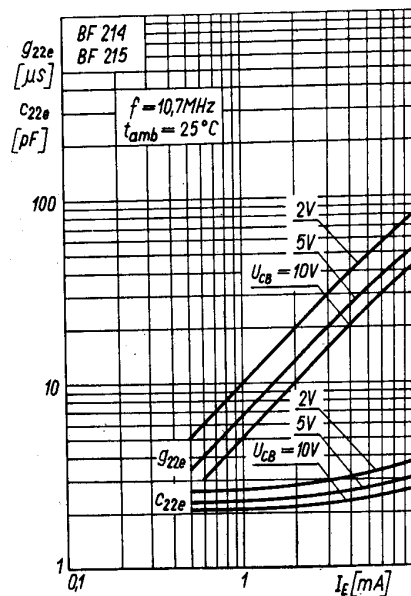
Zależność admitancji wejściowej od prądu emitera g_{11e} ; $C_{11e} = f(I_E)$



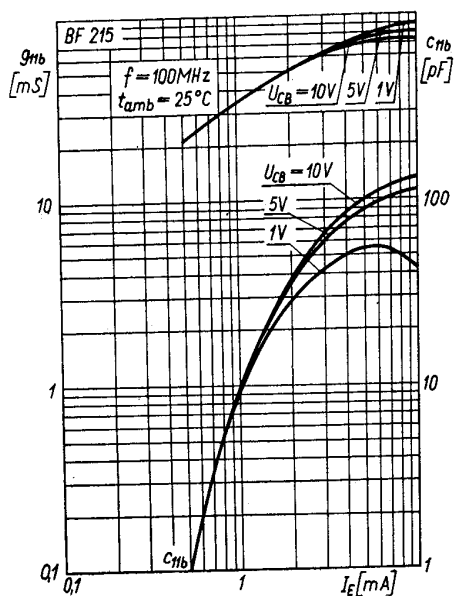
Zależność admitancji przenoszenia wstecz od prądu emitera $|Y_{12e}|$; $\varphi_{12e} = f(I_E)$



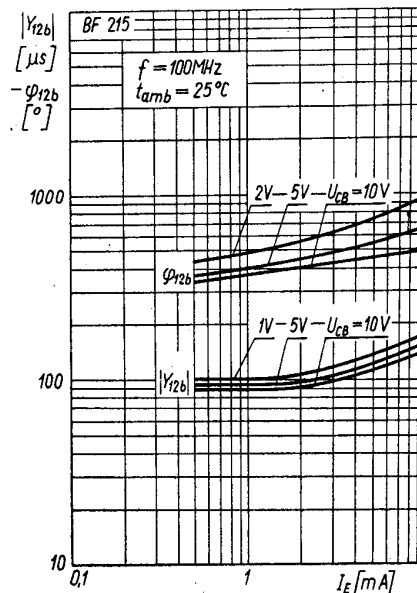
Zależność admitancji przenoszenia w przód od prądu emitera $|Y_{21e}|$; $\varphi_{21e} = f(I_E)$



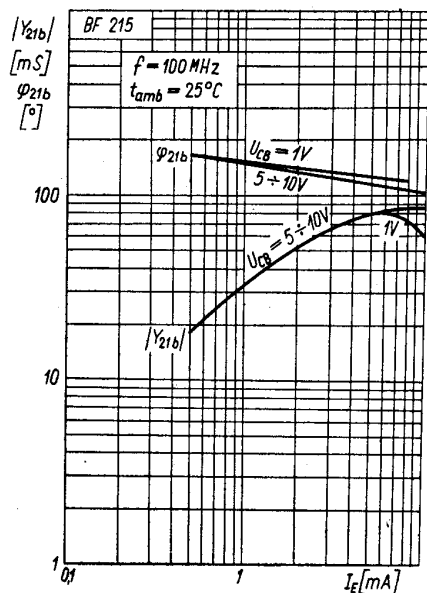
Zależność admitancji wyjściowej od prądu emitera g_{22e} ; $C_{22e} = f(I_E)$



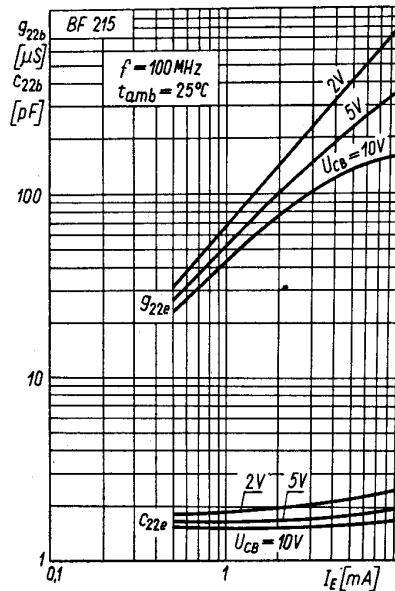
Zależność admitancji wejściowej od prądu emitera g_{11b} ; $C_{11b} = f(I_E)$



Zależność admitancji przenoszenia wstecz od prądu emitera $|Y_{12b}|$; $\varphi_{12b} = f(I_E)$



Zależność admitancji przenoszenia w przód od prądu emitera $|Y_{21b}|$; $\varphi_{21b} = f(I_E)$



Zależność admitancji wyjściowej od prądu emitera g_{22b} ; $C_{22b} = f(I_E)$

PRODUCENT



NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
PÓLPRZEWODNIKÓW „TEWA”
ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219

DYSTRYBUTOR



BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERRADIOTECHNICZNEGO
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435